

S1ZAS4**40V 1.2A****特長**

- SMD
- PRRSMアバランシェ保証
- PRRSM Rating

Feature

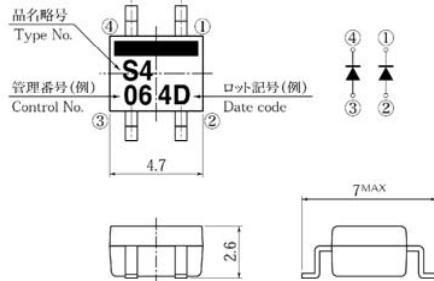
- SMD
- DC/DC Converter
- Home Appliance, Game, Office Automation
- Communication, Portable set

用途

- スイッチング電源
- DC/DCコンバータ
- 家電、ゲーム、OA機器
- 通信、ポータブル機器
- Switching Regulator
- DC/DC Converter
- Home Appliance, Game, Office Automation
- Communication, Portable set

Main Use**外観図 OUTLINE**

Package : 1Z

Unit:mm
Weight 0.13g(Typ)

外形図については新電元Webサイト又は〈半導体製品一覧表〉をご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of the outline dimensions, refer to our web site or Semiconductor Short Form Catalog. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection".

■定格表 RATINGS**●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 T_I = 25°C)**

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	S1ZAS4	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg			-40~150	°C
接合部温度 Operation Junction Temperature	T _j			150	°C
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V _{RM}			40	V
繰り返しせん頭サージ逆電圧 Repetitive Peak Surge Reverse Voltage	V _{RRSM}	パルス幅0.5ms, duty 1/40 Pulse width 0.5ms, duty 1/40		45	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	I _o	50Hz正弦波, 抵抗負荷	アルミナ基板実装 On alumina substrate 1回路通電 Ta = 49°C 1 element operation	1.2	A
		50Hz sine wave, Resistance load	2回路通電 Ta = 45°C 2 element operation	0.9*	
		プリント基板実装 On glass-epoxy substrate	1回路通電 Ta = 47°C 1 element operation	1	
			2回路通電 Ta = 43°C 2 element operation	0.72*	
せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	I _{FSM}	50Hz正弦波, 非繰り返し1サイクルせん頭値, 1素子当りの規格値, T _j = 125°C 50Hz sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, Per diode, T _j = 125°C		40	A
繰り返しせん頭サージ逆電力 Repetitive Peak Surge Reverse Power	P _{RRSM}	パルス幅10μs, 1素子当り, T _j = 25°C Pulse width 10μs, Per diode, T _j = 25°C		60	W

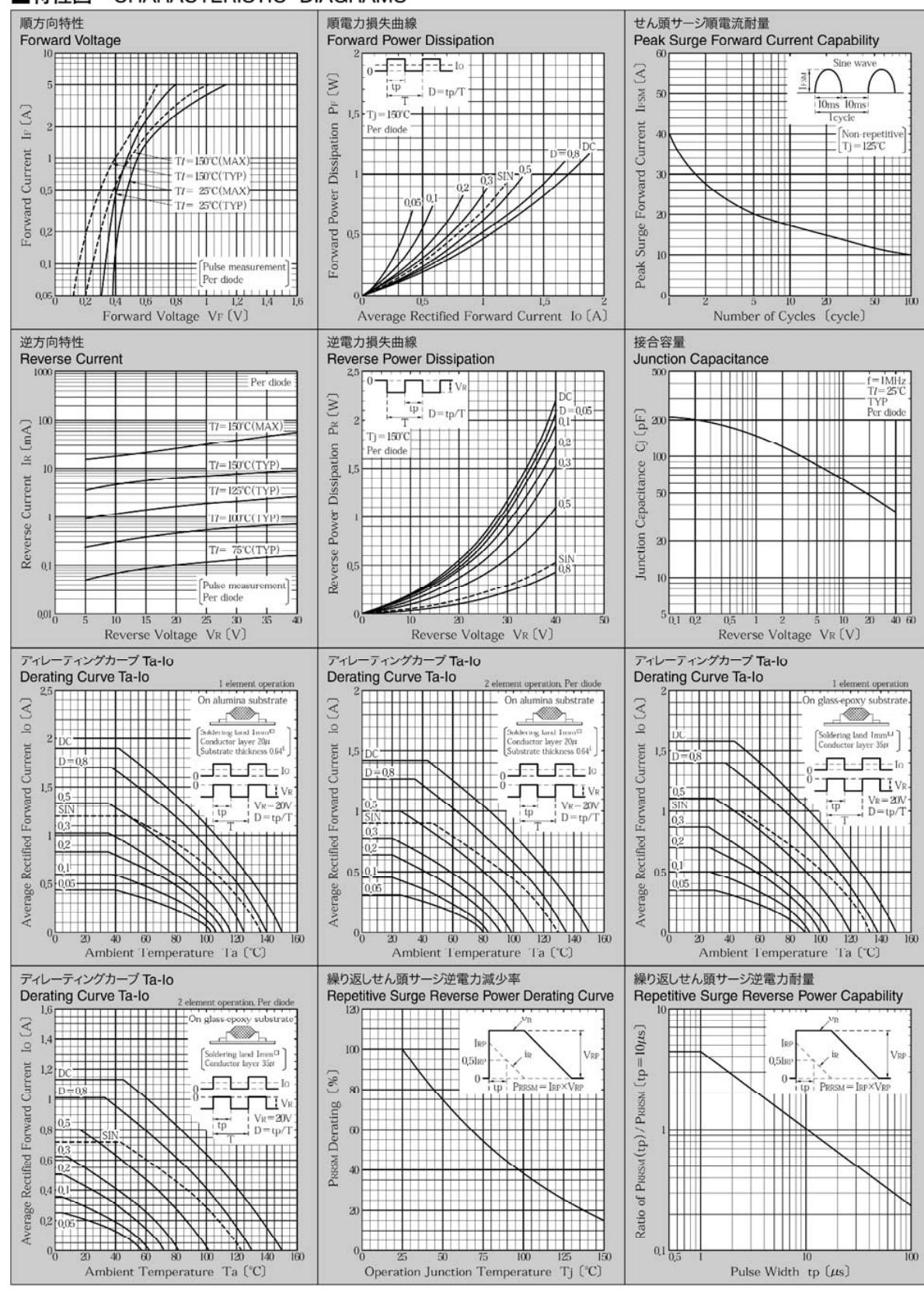
●電気的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 T_I = 25°C)

順電圧 Forward Voltage	V _F	I _F = 1A, V _R = V _{RM} , f = 1MHz	パルス測定, 1素子当りの規格値 Pulse measurement, Per diode	MAX 0.55	V
逆電流 Reverse Current	I _R		パルス測定, 1素子当りの規格値 Pulse measurement, Per diode	MAX 1	mA
接合容量 Junction Capacitance	C _j	f = 1MHz, V _R = 10V,	1素子当りの規格値 Per diode	TYP 65	pF
熱抵抗 Thermal Resistance	θ _{jl}	接合部・リード間 Junction to lead		MAX 25	°C/W
	θ _{ja}	接合部・周囲間 Junction to ambient	アルミナ基板実装 On alumina substrate 1回路通電 1 element operation	MAX 93	
			2回路通電 2 element operation	MAX 140*	
			プリント基板実装 On glass-epoxy substrate 1回路通電 1 element operation	MAX 120	
			2回路通電 2 element operation	MAX 186*	

*: 1 素子当りの規格値 *: Per diode

Array Type

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



* Sine waveは50Hzで測定しています。 * 50Hz sine wave is used for measurements.

* 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っております。 Typicalは統計的な実力を表しています。

* Semiconductor products generally have characteristic variation. Typical is a statistical average of the device's ability.